



印章/Marking: J6

特点/Features:

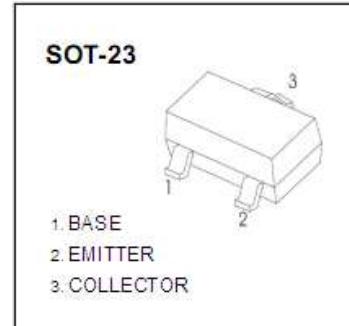
- 1、 h_{FE} 高, $h_{FE}=200 \sim 1000$;
- 2、 h_{FE} 线性特性好,
 $h_{FE} (0.1mA) / h_{FE} (2mA) = 0.95$ (TYP);

用途/Applications:

用于低电平、低噪声的前置放大器，与 S9015 互补。

极限参数/Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CBO}	50	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	45	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_c	0.1	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_c	0.2	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C



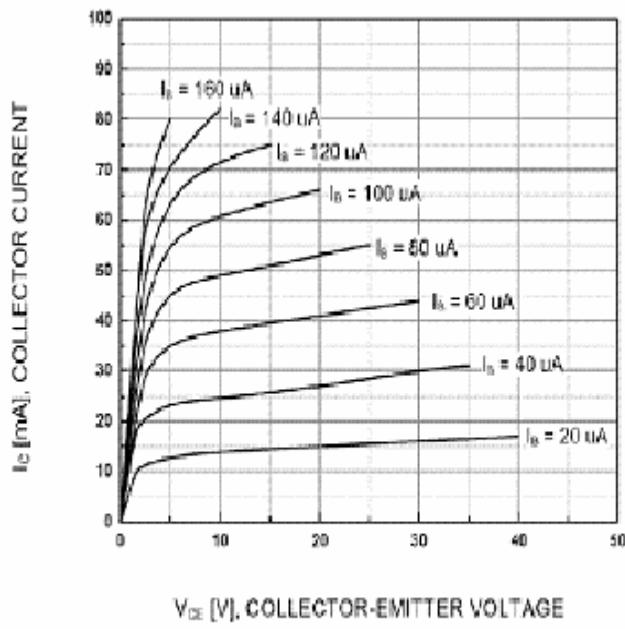
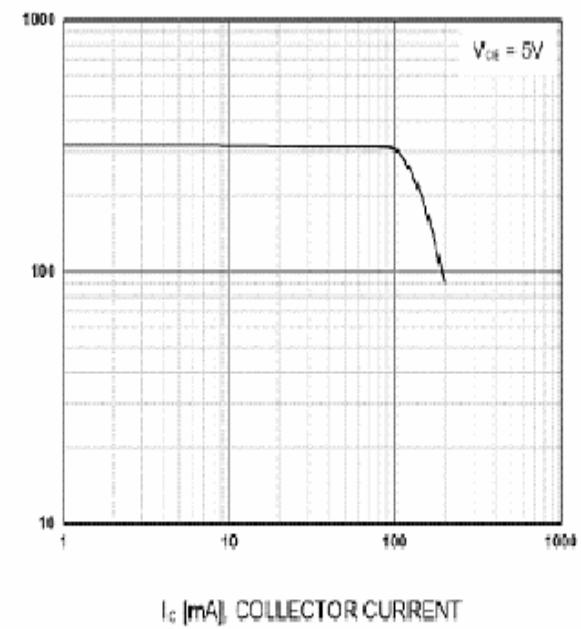
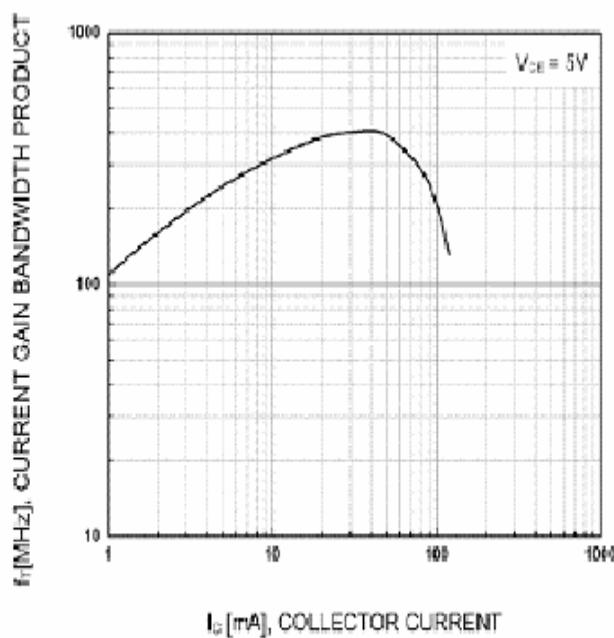
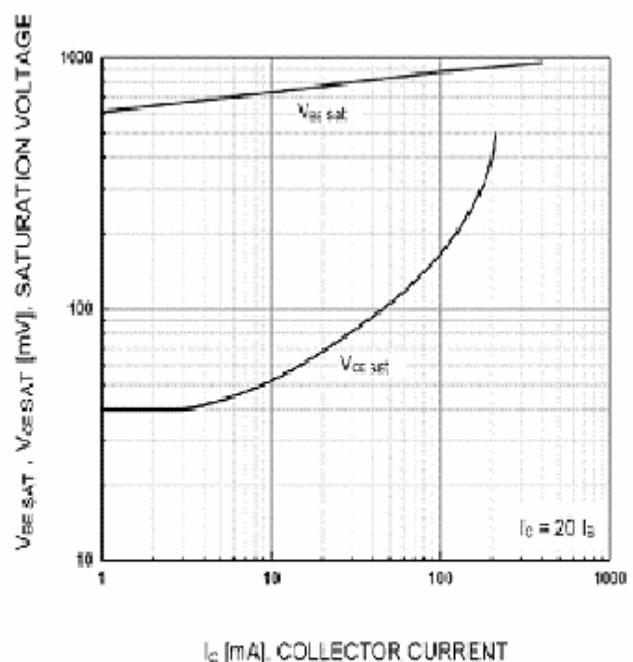
电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CBO)}$	$I_c=100 \mu A, I_E=0$	50			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CEO)}$	$I_c=100 \mu A, I_B=0$	45			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EBO)}$	$I_E=100 \mu A, I_c=0$	5			V
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=50V, I_E=0$			0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=3V, I_c=0$			0.1	μA
集电极发射极穿透电流	I_{CEO}	$V_{CE}=35V, I_B=0$			0.1	μA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_c=1mA$	200		1000	
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_c=100mA, I_B=5mA$			0.3	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_c=100mA, I_B=5mA$			1	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5V, I_c=10mA, f=30MHz$	150			MHz

h_{FE} 分档/Classification of h_{FE}

档位/Rank	L	H
范围/Range	200~450	450~1000

典型特性曲线图/Typical Characteristics


Static Characteristic

DC current Gain

Current Gain Bandwidth Product

**Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage**